

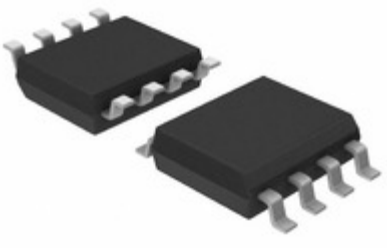









| | |
|---|--|
|  | <p>SI4886DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4886DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4886DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 380 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI4886DY-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 380 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 800mV @ 250µA (Min) |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10 mOhm @ 13A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.56W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9.5A (Ta) |

SI4886DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4886DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4886DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4886DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI4886DY-T1 VISHAY SI4886DY-T1 VISHAY</p> |  <p>SI4886DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p> |  <p>SI4886DY SI SI4886DY SI</p> |  <p>SI4886DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p> |
|  <p>SI4888DY SI SI4888DY SI</p> |  <p>SI4886DY-T1-E3. VISHAY SI4886DY-T1-E3. VISHAY</p> |  <p>SI4888 SI SI4888 SI</p> |  <p>SI4888AN SIL SI4888AN SIL</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SI4886DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI4886DY-T1-GE3 Datenblatt | SI4886DY-T1-GE3-Datenblätter | SI4886DY-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI4886DY-T1-GE3 |
| SI4886DY-T1-GE3 Electronic | SI4886DY-T1-GE3-Komponenten | SI4886DY-T1-GE3-Verteiler | SI4886DY-T1-GE3-Bild | SI4886DY-T1-GE3-Teil |
| SI4886DY-T1-GE3 Preis | SI4886DY-T1-GE3 Hersteller | SI4886DY-T1-GE3 Bild | SI4886DY-T1-GE3 Aktie | SI4886DY-T1-GE3 Inventar |
| SI4886DY-T1-GE3 Neu | SI4886DY-T1-GE3 Original | SI4886DY-T1-GE3 garantiert | SI4886DY-T1-GE3 RFQ | SI4886DY-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited